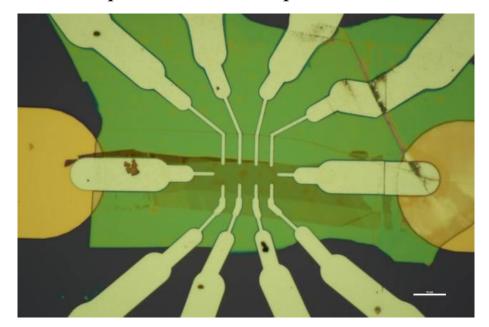
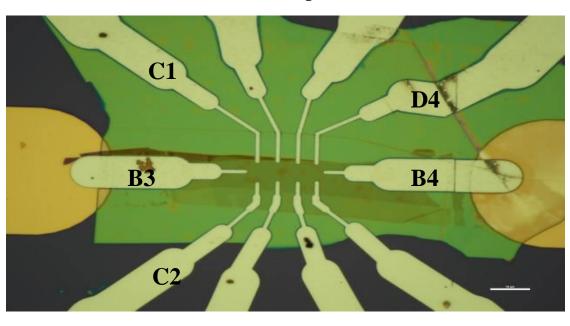
Первоначальный образец, NeSe2



## Схема измерений № 1



B4(+) -> B3(-) токозадающие

D4(+) -> C1(-)  $U_{\chi\chi4}$ 

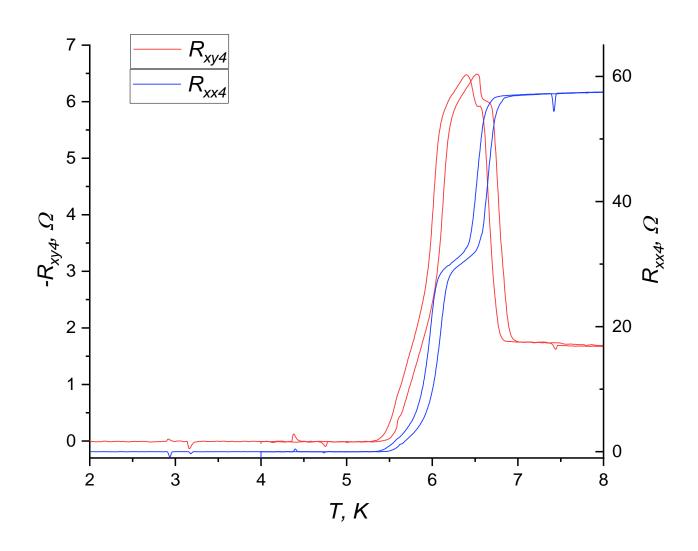
C1(+) -> C2(-)  $U_{xy4}$ 

# Сверхпроводимость. Температурная зависимость в нулевом поле

Lock-ins, график по сигналу  $U_{ip}$ 

$$I = 500nA, B = 0T$$

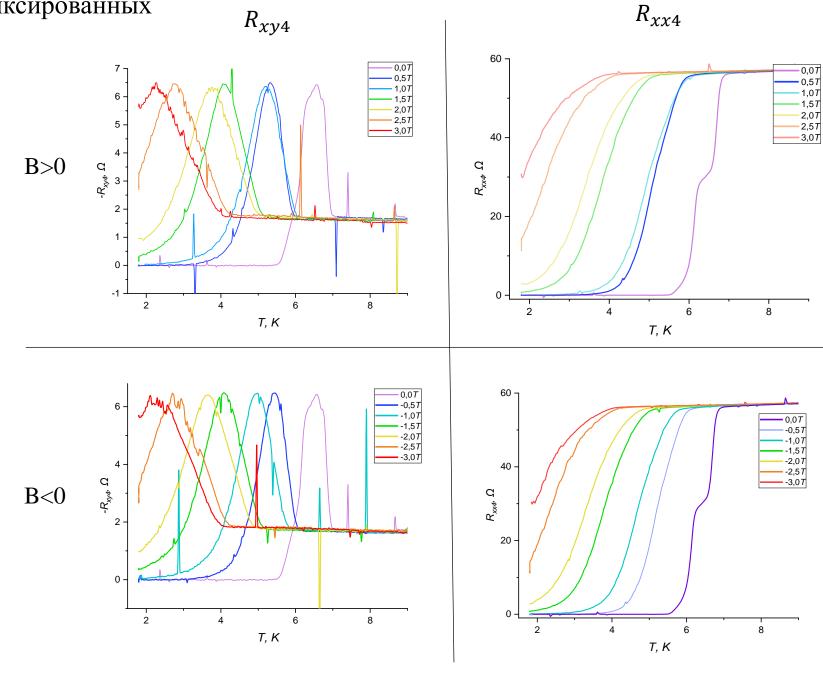
$$R_{xy} = \frac{U_{xy\_ip}}{I}$$



Температурная зависимость при фиксированных полях B

$$\nu=8.11$$
Hz, Lock-ins,  $I=500nA$ 

$$R_{xy} = \frac{U_{xy\_ip}}{I}$$

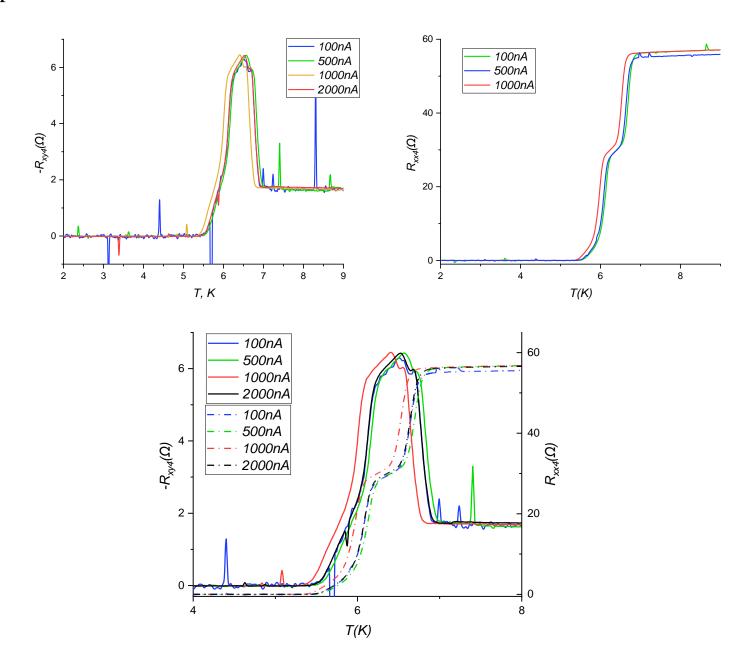


## Температурная зависимость при фиксированных токах

Lock-ins, график по сигналу  $U_{ip}$ 

$$B = 0T$$

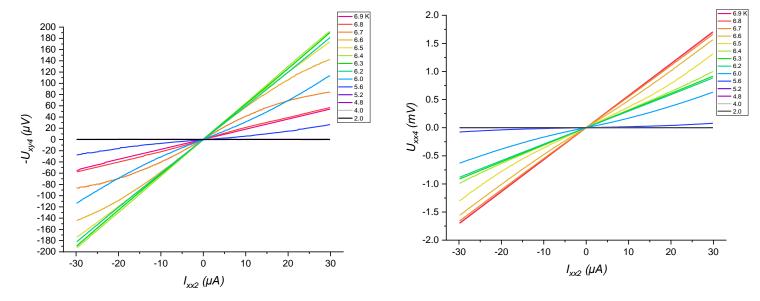
$$R_{xy} = \frac{U_{xy\_ip}}{I}$$



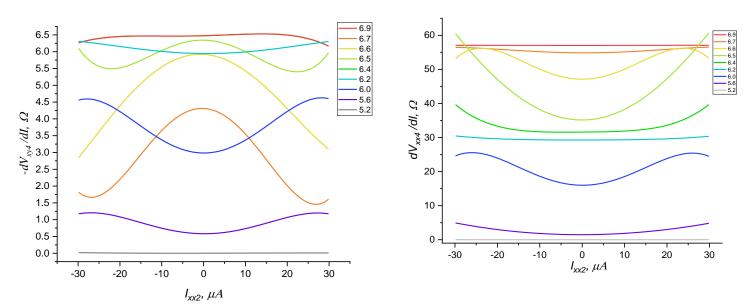
ВАХи при фиксированных температурах.

#### NanovoltMeters and SourceMeter

$$B = 0T$$



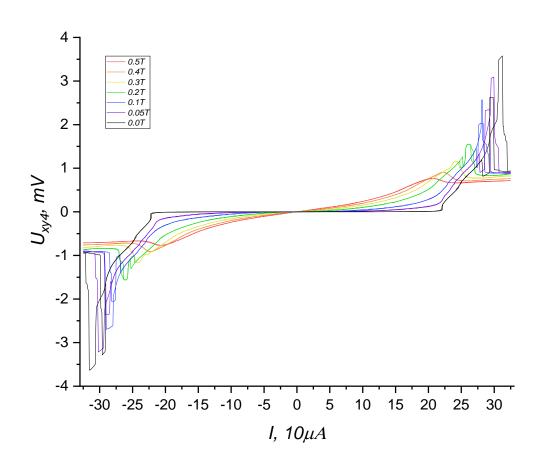
#### Аппроксимация полиномом 5 степени

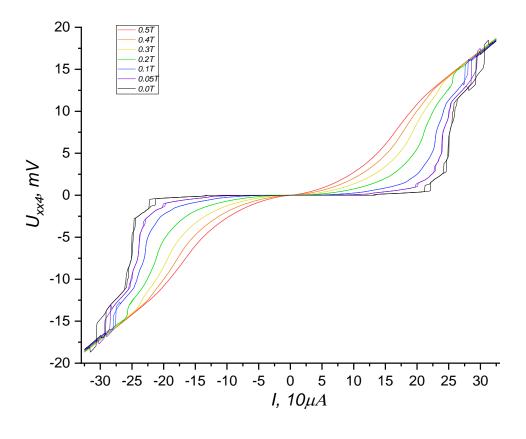


ВАХ, Гистерезис по току при фиксированных полях B.

#### NanovoltMeters and SourceMeter

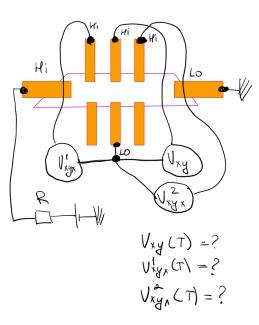
$$B = 0 T$$



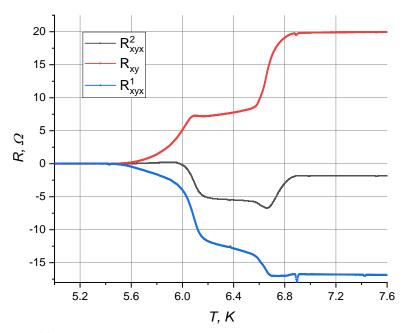


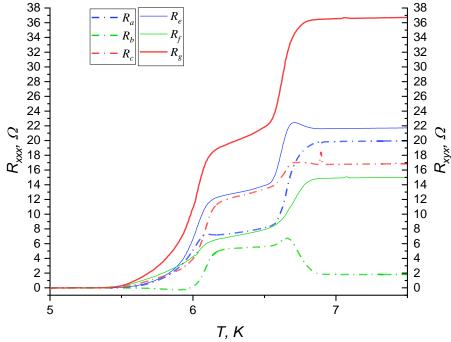
## Схема отделения ХҮ и ХХ компонет

$$\nu=8.11$$
Hz,  $I=1\mu A$ 

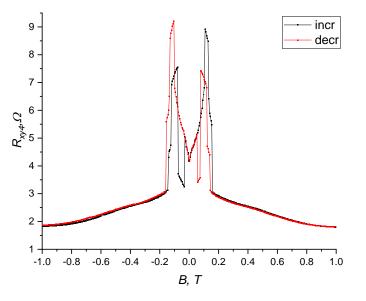


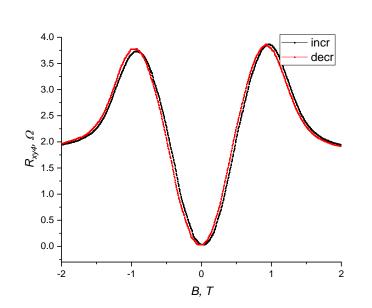




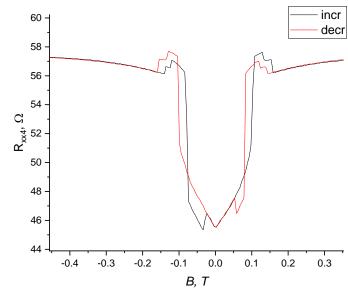


$$T = 4 K$$

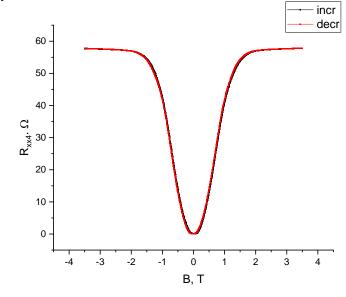




## $I = 280 \mu A$

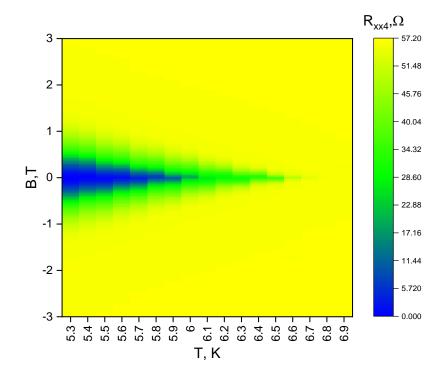


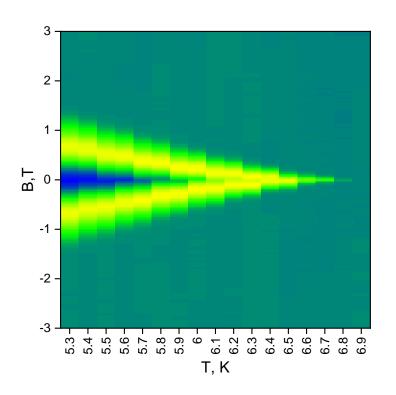
$$I = 30\mu A$$

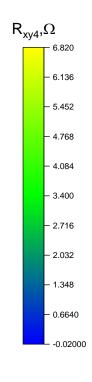


# Карта сопротивления R от (B, T)

$$I = 1uA$$

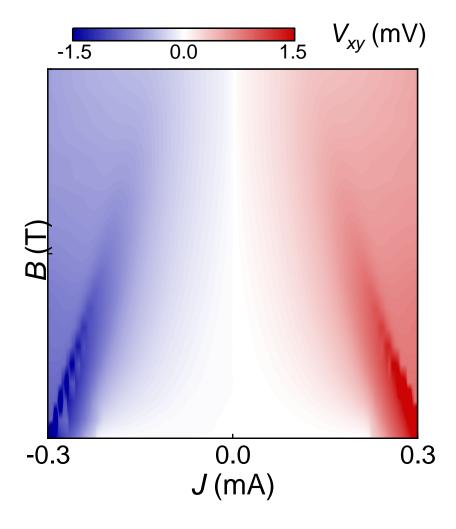






Карта сопротивления R от (B, I)

$$T = 4K$$



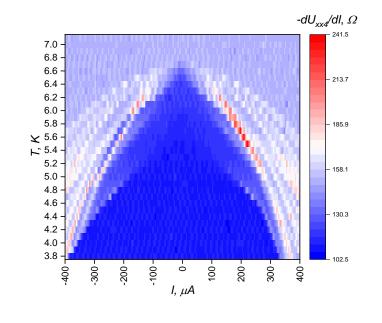
## Карты U(T-I). При увеличении тока

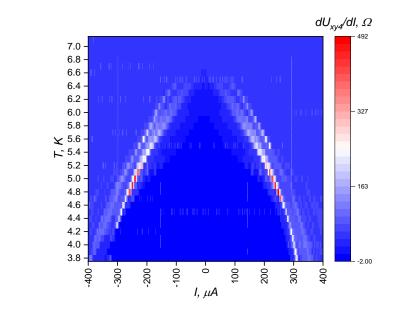
 $I_{ampl\_ac} = 2 \mu A,$   $I_{ampl\_dc} = 400 \mu A$ B = 0 T

Дифференциальные сопротивления

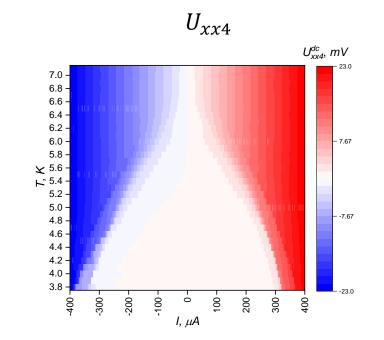
Lock-ins

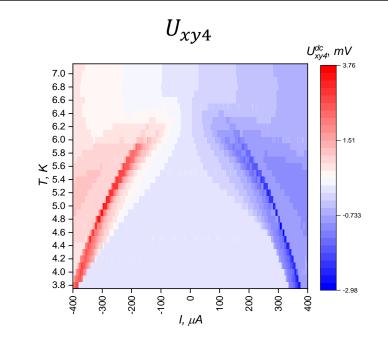
 $\mathsf{AC}$ 



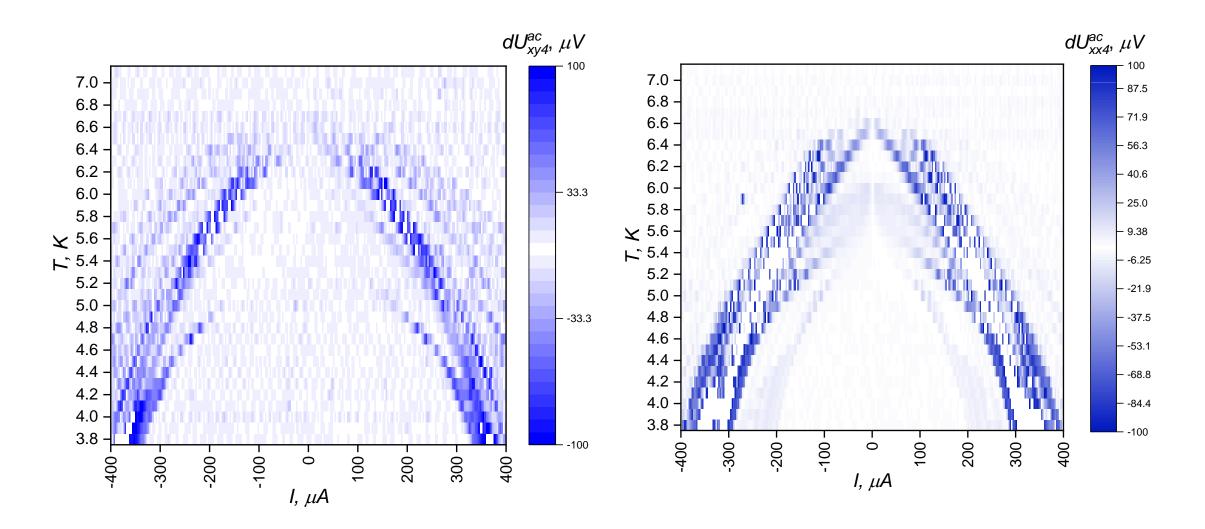


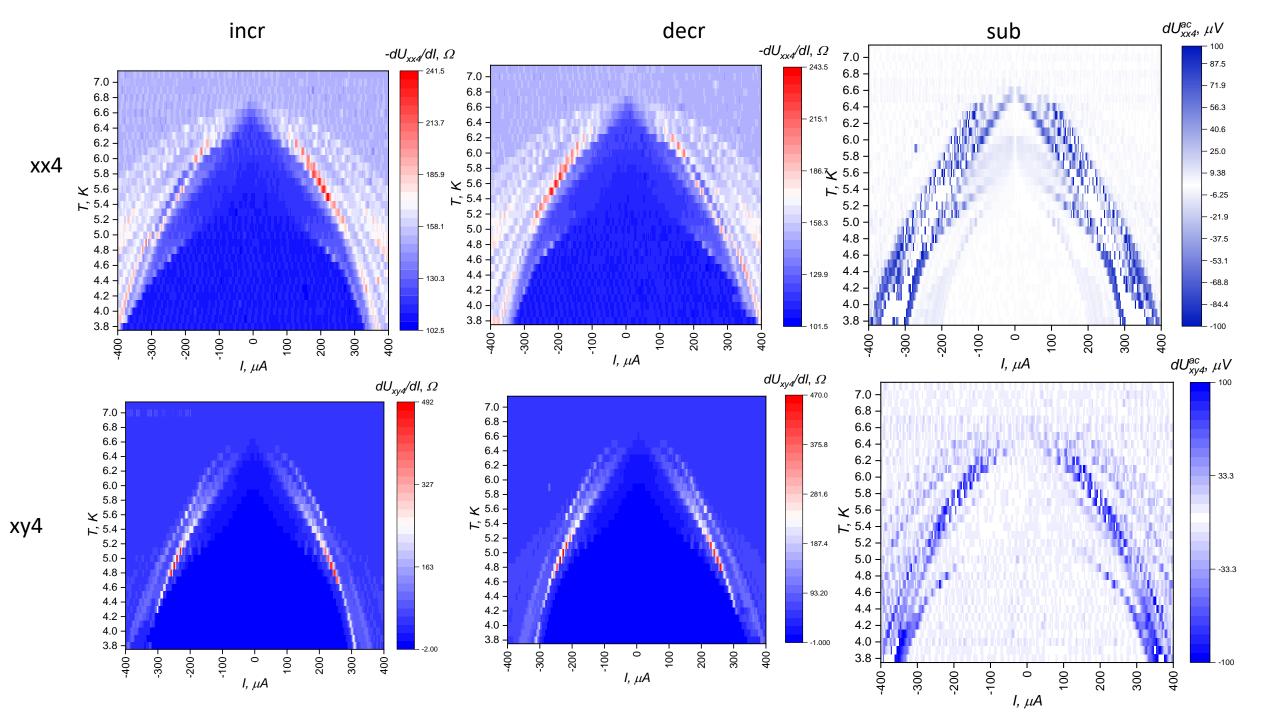




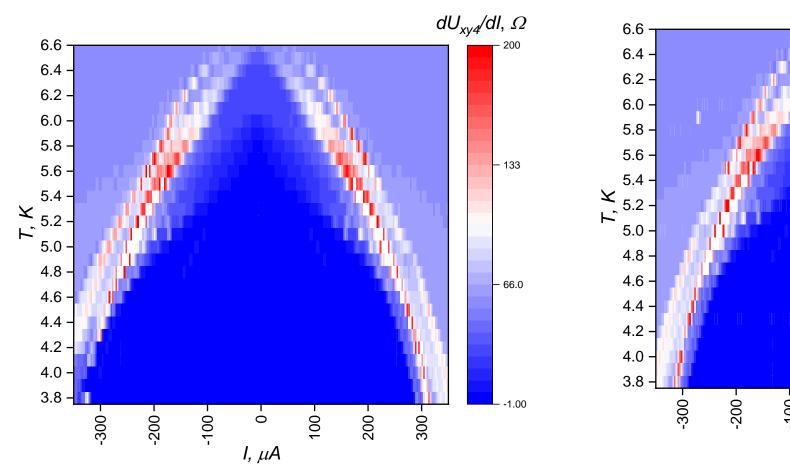


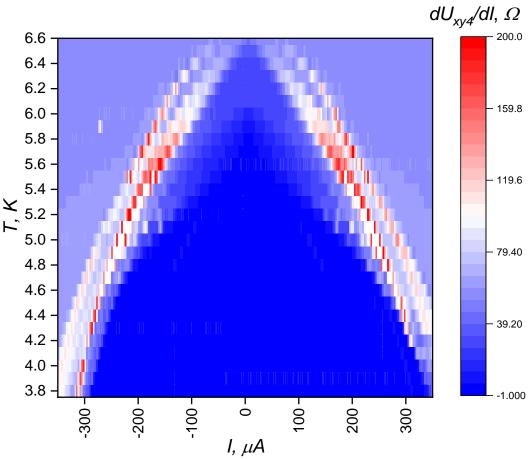
## Разность сигналов для исследования гистерезиса по току. Разность из данных по возрастанию и по уменьшению тока





#### Как будто области отображаются друг на друга





#### Как будто области отображаются друг на друга

